

# بررسی ویژگی‌های دی‌الکتریک شیشه سرامیک سیستم CaO-SiO<sub>2</sub>-MgO در محدوده امواج مایکروویو

محبوبه کیانی زیتانی<sup>۱\*</sup>، محمد رضوانی<sup>۲</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، گروه مهندسی مواد، تبریز، ایران

۲- دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

\* Mahbube\_kiani88@ms.tabrizu.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۰۷/۱۹، تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۱/۲۹)

## چکیده

افزایش تقاضا برای دی‌الکتریک‌های با ثابت دی‌الکتریک و اتلاف دی‌الکتریک پایین (برای افزایش سرعت سیگنال) در محدوده طول موج مایکروویو منجر به افزایش روند تحقیقات در زمینه دی‌الکتریک‌های مایکروویو شده است. همچنین شیشه سرامیک‌ها دارای ویژگی‌های دی‌الکتریک برتر از فلزات و پلیمرهای آلی هستند. در این تحقیق سینترپذیری و ویژگی‌های دی‌الکتریک شیشه سرامیک سیستم CaO-SiO<sub>2</sub>-MgO بررسی شده است. نتایج حاصل از سینترپذیری نشان داد که این ترکیب برای کاربردهای دما پایین (LTCC) با دمای زینترینگ °C ۸۶۰-۸۰۰ (> ۱۰۰۰ °C) مناسب می‌باشد. شیشه سرامیک سینتر شده در دمای °C ۸۶۰ ثابت دی‌الکتریک ۶/۱۳ و اتلاف ۰/۰۰۳۷ را در محدوده ۸-۱۲ گیگاهرتز نشان داد.

## واژه‌های کلیدی:

ثابت دی‌الکتریک، اتلاف دی‌الکتریک، شیشه سرامیک بر پایه فاز آکرومانیت، دایوساید، ولاستونیت

## ۱- مقدمه

ساخت تجهیزات الکترونیکی، فناوری LTCC<sup>۳</sup> با سرعت بالا و عملکرد مناسب، برای تجهیزات، زیرلایه‌ها، مدول‌ها و اجزاء الکترونیکی مجتمع مورد توجه قرار گرفت. اجزاء غیرفعال<sup>۴</sup> (مانند القاگرها<sup>۵</sup> و خازن‌ها) در میان زیرلایه‌ها تعبیه و با فلزات رسانا (مانند نقره و مس) در دماهای پایین بطور همزمان سینتر می‌شوند [۵]. دمای پایین بدین معنی است که زیرلایه‌های سرامیکی باید در دماهای کمتر از °C ۱۰۰۰ به منظور سینتر دوباره با مس (°C ۱۰۸۳)، نقره (°C ۹۶۱) و طلا (°C ۱۰۶۱)

شیشه سرامیک‌ها گروهی از مواد سرامیکی هستند که از جوانه‌زنی و تبلور کنترل شده شیشه تشکیل می‌شوند [۱]. به‌طور معمول ریزساختار حاصل شده ۵۰-۹۵ درصد حجمی، بلوری است [۲]. در نتیجه‌ی پیشرفت سریع در تلفن همراه و سیستم‌های ارتباطات ماهواره‌ای، مواد دی‌الکتریک در فرکانس‌های مایکروویو گسترش یافتند [۲-۳]. سرامیک‌های ثابت دی‌الکتریک پایین به عنوان زیرلایه<sup>۱</sup>، مدارهای مجتمع مایکروویو<sup>۲</sup> استفاده می‌شوند [۴]. از میان روش‌های مختلف

سیستم نام برده در بین سیستم های مشهور دی الکتریک از کمترین اتلاف دی الکتریک برخوردار است [۱۲]. در سال ۲۰۰۹، M.Chang و همکارانش ترکیبات مختلف سیستم فوق را در دمای  $870^{\circ}\text{C}$  سینتر کردند. فاز دایوپساید به عنوان فاز اصلی تبلور یافت. ثابت دی الکتریک برای همه نمونه ها در ۱ مگاهرتز در محدوده  $7/2-8/1$  و اتلاف دی الکتریک کمتر از  $0/015$  بود [۱۲]. در سال ۲۰۰۹، H.Wang و همکارانش با استفاده از روش سل - ژل در سیستم فوق به ثابت دی الکتریک  $7/16$  دست یافتند [۱۶]. با توجه به اینکه ویژگی های دی الکتریک شیشه سرامیک های آکرماتیسی چندان بررسی نشده، در این تحقیق تلاش شده است ویژگی های دی الکتریک شیشه سرامیک سیستم  $\text{CaO-MgO-SiO}_2$  بر پایه فاز آکرماتیت با دمای ذوب و دماهای سینترینگ پایین، مورد بررسی قرار گیرد.

## ۲- مواد و روش تحقیق

ترکیب شیشه پایه بصورت  $36\%\text{CaO}-48\%\text{SiO}_2-16\%\text{MgO}$  (wt%) به منظور بررسی ویژگی های دی الکتریک شیشه سرامیک سیستم  $\text{CaO-MgO-SiO}_2$  بر پایه فاز آکرماتیت، ترکیب انتخاب شده در نمودار سه فاز  $\text{CaO-MgO-SiO}_2$  در منطقه فازی آکرماتیت قرار دارد. همچنین ترکیب انتخاب شده به خطوط دمایی با دماهای پایین نزدیک است. با استفاده از مواد اولیه مصرفی شامل سیلیس، کربنات کلسیم و هیدروکسید منیزیم با خلوص بالای  $99/5\%$ ، بیج ترکیب فوق، برای ذوب در بوتله زیر کنی، توزین شد. ترکیب در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$  با نرخ  $10^{\circ}\text{C min}^{-1}$  و زمان نگهداری ۱ ساعت ذوب، و در آب سرد کوئنچ شد. فریت بدست آمده به مدت ۲ ساعت در خشک کن قرار داده شد، سپس با استفاده از هاون برقی به مدت ۴۵ دقیقه آسیاب شده و به اندازه دانه زیر  $63$  میکرون تبدیل شد. به منظور بررسی رفتار تبلور از آنالیز حرارتی افتراقی دستگاه Pyris TG/DTA, Perkin Elmer استفاده شد. نمونه های قرصی شکل با قطر  $22$  mm و ضخامت  $4$  mm با استفاده از روش پرس

سینتر شوند [۶-۹]. به طور کلی مواد LTCC در دو گروه تقسیم بندی می شوند: مواد زیرلایه با ثابت دی الکتریک پایین ( $\epsilon_r < 10$ ) و مواد مورد استفاده در خازن که ثابت دی الکتریک متوسط یا بالایی دارند. به علت کنترل آسان خواص دی الکتریک و استحکام مکانیکی عالی، شیشه سرامیک ها به عنوان زیرلایه های سرامیکی چند منظوره با ثابت دی الکتریک پایین، استحکام بالا و ضریب انبساط حرارتی پایین استفاده می شوند [۱۰-۱۱]. سیستم های  $\text{CaO-B}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ ،  $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ ،  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  و  $\text{CaO-MgO-SiO}_2$  مهم ترین شیشه سرامیک های گزارش شده با ثابت دی الکتریک پایین برای کاربردهای LTCC هستند [۱۲]. در سال ۲۰۰۸ Ch.Chiang و همکارانش ترکیبات مختلف سیستم  $\text{CaO-B}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  را در محدوده دمایی  $750^{\circ}\text{C}$  تا  $1260^{\circ}\text{C}$  سینتر نمودند. در فرکانس  $10$  گیگاهرتز ثابت دی الکتریک در دو گروه  $4-5$  و  $7-8$  گزارش شد. اتلاف دی الکتریک همه نمونه ها زیر  $0/005$  بود [۱۳]. Zhu و همکارانش در سال ۲۰۰۹ ترکیباتی از سیستم نام برده را به همراه افزودنی های  $\text{ZrO}_2 + \text{TiO}_2 + \text{P}_2\text{O}_5 + \text{ZnO}$  و  $\text{B}_2\text{O}_3$  در دمای  $820^{\circ}\text{C}$  و  $900^{\circ}\text{C}$  سینتر کردند. شیشه سرامیک های بدست آمده خواص مکانیکی بهتری داشتند، اما خواص دی الکتریک نامناسبی از خود نشان دادند. در فرکانس  $10$  گیگاهرتز، ثابت دی الکتریک  $6/51$  و  $7/07$  و اتلاف دی الکتریک  $0/0029$  و  $0/0019$  گزارش شد [۱۴]. شیشه سرامیک های بر پایه فاز کورد ریت ( $2\text{MgO}.2\text{Al}_2\text{O}_3.5\text{SiO}_2$ ) به دلیل ثابت دی الکتریک پایین و ضریب انبساط حرارتی پایین برای کاربردهای الکترونیکی مناسب می باشند، اما در فرآیند ساخت به روش ذوب نیاز به دمای بالایی ( $\geq 1600^{\circ}\text{C}$ ) دارند. به علت ویسکوزیته بالای فاز آمورف و محدوده باریک دمای سینترینگ، بدست آوردن شیشه سرامیک های چگال با دمای عملیات حرارتی کمتر از  $1000^{\circ}\text{C}$  مشکل است [۱۵]. شیشه سرامیک سیستم  $\text{CaO-MgO-SiO}_2$  نیز به عنوان یکی دیگر از سیستم های شیشه سرامیکی با ثابت دی الکتریک پایین و ویژگی های دی الکتریک خوب شناخته شده است [۱۰ و ۱۶].

آمورف را نشان می‌دهد اما الگوی XRD این دما در زاویه  $2\theta$  حدود  $31^\circ$  درجه، نشان دهنده تغییراتی مبنی بر تبلور فازی است که افزایش دما نیز این تغییرات را اثبات می‌کند. همان‌طور که در الگوی XRD دمای  $830^\circ\text{C}$  مشاهده می‌شود، با افزایش دما، تبلور فازی در شیشه رخ می‌دهد. در نتیجه آن فازهای آکرمائیت ( $2\text{CaO}\cdot 2\text{SiO}_2\cdot \text{MgO}$ )، دایوپساید ( $\text{CaO}\cdot 2\text{SiO}_2\cdot \text{MgO}$ ) و ولاستونیت ( $\text{CaO}\cdot \text{SiO}_2$ ) در این دما با استفاده از CCD Card (01-088-0777, 01-086-0932, 01-072-2284) شناسایی شدند. فاز آکرمائیت شدت بیشتری نسبت به دو فاز دیگر دارد. با افزایش دما تا  $860^\circ\text{C}$  شدت پیک‌های تبلور افزایش یافت.

به منظور بررسی سینترپذیری شیشه سرامیک‌های عملیات حرارتی شده، دانسیته بالک، انقباض، جذب آب و تخلخل نمونه‌ها به روش ارشمیدس و دانسیته پیکنومتری اندازه‌گیری شد. همان‌طور که در جدول (۱) مشاهده می‌شود با افزایش دما از  $800^\circ\text{C}$  تا  $860^\circ\text{C}$  دانسیته نسبی و انقباض، ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد. در طی سینترینگ نمونه‌های فریت شکل داده شده، سطح ویژه و انرژی سطحی کاهش می‌یابد. به عبارتی در عملیات حرارتی شیشه سرامیک‌ها دو فرآیند سینترینگ و تبلور همزمان رخ می‌دهد. اما تبلور در طی عملیات حرارتی سبب کاهش سرعت سینترینگ می‌شود [۱۷-۱۸]. به همین دلیل با افزایش دما از  $800^\circ\text{C}$ ، افزایش تبلور سبب افزایش ویسکوزیته فاز آمورف شده و بنابراین دانسیته نسبی و انقباض خطی کاهش می‌یابد. دمای  $860^\circ\text{C}$  بیشترین دانسیته نسبی، انقباض و کمترین مقدار تخلخل بسته را نشان می‌دهد. این امر بیانگر کامل شدن فرآیند سینترینگ در این دما است.

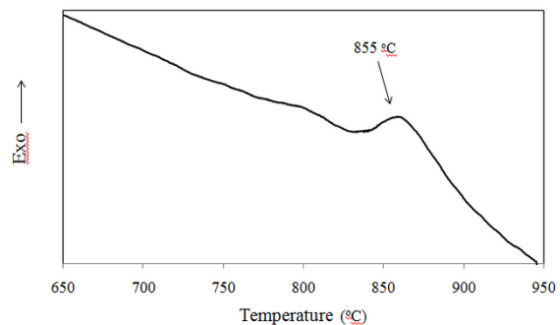
در نتیجه نمونه عملیات حرارتی شده در دمای  $860^\circ\text{C}$  به عنوان نمونه بهینه با ویژگی‌های فیزیکی مناسب انتخاب می‌شود.

به منظور بررسی ویژگی‌های دی‌الکتریک، نمونه‌ی شیشه سرامیک با ابعاد  $7 \text{ mm} \times 10/6 \times 22/8$  با فشار  $30 \text{ MPa}$  پرس شد. با استفاده از دستگاه Network Analyzers در محدوده  $12\text{-}8 \text{ GHz}$  (باند x)، ثابت دی‌الکتریک و تانژانت تلفات نمونه‌ها اندازه‌گیری شدند. با استفاده از روش موج بر  $Y$

با فشار  $30 \text{ MPa}$  شکل داده شدند. دماهای مختلف عملیات حرارتی با نرخ  $10^\circ\text{C min}^{-1}$  و زمان نگهداری ۱ ساعت انتخاب شدند. به منظور بررسی سینترپذیری شیشه سرامیک‌های بدست آمده، دانسیته، انقباض، جذب آب و درصد تخلخل نمونه‌ها به روش ارشمیدس و دانسیته پیکنومتری اندازه‌گیری شد. نوع فازهای بلورین با استفاده از نتایج بدست آمده توسط پراش سنج Siemens D500, Germany شناسایی شدند. در نهایت ویژگی‌های دی‌الکتریک با استفاده از دستگاه Network Analyzers, 8757D محصول شرکت Agilent اندازه‌گیری شدند.

### ۳- نتایج و بحث

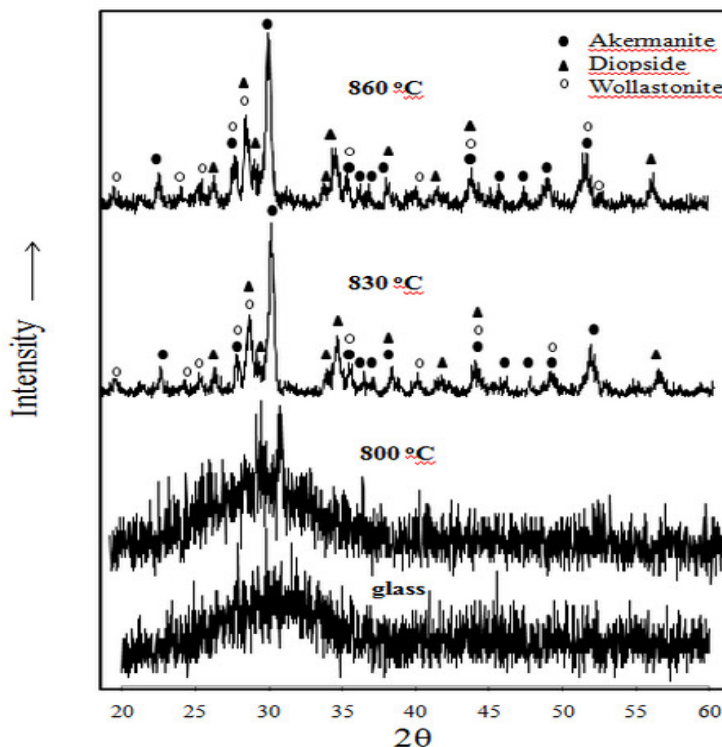
شکل (۱) آنالیز حرارتی DTA شیشه  $36\%\text{CaO-}48\%\text{SiO}_2\text{-}16\%\text{MgO}$  را نشان می‌دهد.



شکل (۱): آنالیز حرارتی DTA شیشه  $\text{CaO-MgO-SiO}_2$

با استناد به منحنی DTA دمای بیشینه تبلور  $T_p$   $855^\circ\text{C}$  بدست آمده است. با توجه به نتیجه بدست آمده از شکل (۱)، دماهای  $800^\circ\text{C}$ ،  $830^\circ\text{C}$  و  $860^\circ\text{C}$  با فاصله دمایی  $30^\circ\text{C}$  به عنوان دماهای عملیات حرارتی با مدت زمان نگهداری ۱ ساعت در نظر گرفته شد. شکل (۲) الگوی پراش اشعه ایکس XRD نمونه‌های تبلور یافته در دماهای مختلف را نشان می‌دهد. همان‌طور که در الگوی XRD شیشه‌ی سیستم نام‌برده مشاهده می‌شود به‌طور کامل آمورف می‌باشد و هیچ پیک تبلوری در آن مشاهده نمی‌شود. همچنین در دمای  $800^\circ\text{C}$  نیز الگوی XRD حالت

اندازه گیری ویژگی های دی الکتریک نمونه شیشه سرامیک انجام شد. شکل (۳) نمونه ای از موج بر محدوده باند X به همراه قطعات دی الکتریک آماده سازی شده را نشان می دهد.



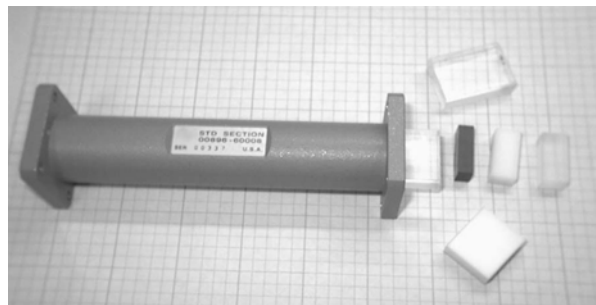
شکل (۲): الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) نمونه های عملیات حرارتی شده در دماهای ۸۰۰ °C، ۸۳۰ و ۸۶۰ و زمان نگهداری ۱ ساعت

جدول (۱): ویژگی های فیزیکی نمونه های عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف

نمونه ها	درصد انقباض	دانسیته بالک (gr/Cm <sup>3</sup> )	درصد تخلخل باز	دانسیته نسبی	درصد تخلخل بسته
۸۰۰ °C	۱۳/۵۲	۲/۹۴	۰/۰۰	۰/۸۸	۱۲
۸۳۰ °C	۱۲/۱۶	۲/۹۳	۰/۰۰	۰/۷۹	۲۱
۸۶۰ °C	۱۴/۳۰	۳/۰۰	۰/۰۰	۰/۹۶	۴

اساس اندازه گیری به روش موج بر، تبدیل پارامترهای S به ثابت دی الکتریک به شکل عدد مختلط می باشد. پارامترهای S به شکل S<sub>11</sub> و S<sub>21</sub> به ترتیب سیگنال های بازتابیده و عبوری هستند. با استفاده از روابط (۱) تا (۶) ثابت دی الکتریک نمونه شیشه سرامیک به شکل عدد مختلط محاسبه گردید [۱۹].

$$K = \frac{S_{11}^2 - S_{21}^2 + 1}{2S_{11}} \quad (1)$$



شکل (۳): نمونه ای از موج بر باند X با قطعات دی الکتریک آماده سازی شده

نمی‌آید. ثابت دی‌الکتریک و اتلاف دی‌الکتریک اندازه‌گیری شده برای نمونه عملیات حرارتی شده در دمای ۸۶۰°C برای تمامی فرکانس‌های محدوده ۸-۱۲ GHz (باند x) با تغییرات بسیار ناچیزی به ترتیب ۶/۱۳ و ۰/۰۳۷ بدست آمد. در شیشه سرامیک‌ها، ترکیب شیمیایی شیشه پایه، مقدار و نوع فازهای بلورین تشکیل شده و ریزساختار (ابعاد و شکل ذرات بلورین، نوع آرایش آنها، مقدار تخلخل...) تعیین کننده ویژگی‌های نهایی قطعه خواهد بود. همچنین این عوامل بر ثابت دی‌الکتریک نمونه نیز مؤثر خواهند بود [۱۰-۲۳]. ثابت دی‌الکتریک و اتلاف دی‌الکتریک بدست آمده در نمونه به ترکیب شیشه پایه و فازهای تبلور یافته وابسته است. فازهای تبلور یافته در نمونه عملیات حرارتی شده در دمای ۸۶۰°C فازهای آکرمایت، دایوساید و ولستونیت هستند که فاز عمده تشکیل شده فاز آکرمایت است. بنابراین ویژگی‌های اندازه‌گیری شده در نتیجه تبلور فاز آکرمایت در نمونه می‌باشد.

#### ۴- نتیجه‌گیری

۱- شیشه سرامیک 36%CaO-48%SiO<sub>2</sub>-16%MgO با دمای ذوب پایین ۱۴۰۰°C و دمای عملیات حرارتی ۸۶۰°C (> ۱۰۰۰°C) نشان داد که برای تکنولوژی LTCC مناسب می‌باشد.

۲- بیشترین دانسیته نسبی در دمای ۸۶۰°C بدست آمد.

۳- ثابت دی‌الکتریک ۶/۱۳ و اتلاف دی‌الکتریک ۰/۰۳۷ بدست آمده در این تحقیق نشان می‌دهد که شیشه سرامیک 36%CaO-48%SiO<sub>2</sub>-16%MgO برای کاربردهای الکتریکی مناسب است و نسبت به تحقیقات پیشین در سیستم CaO-MgO-SiO<sub>2</sub>، ثابت دی‌الکتریک پایین تری به دست آمد در نتیجه ویژگی‌های دی‌الکتریک بهبود یافته است.

۴- از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که فاز آکرمایت به عنوان فازی با ویژگی‌های دی‌الکتریک خوب یعنی ثابت دی‌الکتریک و اتلاف دی‌الکتریک پایین است.

$$\Gamma = \kappa \pm \sqrt{\kappa^2 - 1} \quad (۲)$$

$$T = \frac{S_{11} + S_{21} - \Gamma}{1 - (S_{11} + S_{21})\Gamma} \quad (۳)$$

$$X = \left( \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} \right)^2 \quad (۴)$$

$$y = \left\{ \frac{c}{\omega d} \ln \left( \frac{1}{T} \right) \right\}^2 \quad (۵)$$

$$\varepsilon_r = \sqrt{\frac{x}{y}} \quad (۶)$$

که d ضخامت نمونه، c سرعت نور در فضای آزاد،  $\omega$  سرعت زاویه‌ای و  $\varepsilon_r$  ثابت دی‌الکتریک ماده است.

برای نمونه عملیات حرارتی شده در دمای ۸۶۰°C ثابت دی‌الکتریک در محدوده فرکانس ۸-۱۲ GHz (باند x) به شکل عدد مختلط ۶/۱۳-۰/۰۳۷i حاصل شد. بخش حقیقی عدد مختلط به عنوان ثابت دی‌الکتریک و نسبت بخش موهومی به حقیقی را اتلاف دی‌الکتریک می‌نامند. با توجه به عدد مختلط بدست آمده ثابت دی‌الکتریک ۶/۱۳ و اتلاف دی‌الکتریک ۰/۰۳۷ حاصل شد. واکنش دی‌الکتریک تابع پیچیده‌ای از فرکانس، دما و نوع جامد است. تحت شرایط DC، همه سازوکارها عملی هستند و ثابت دی‌الکتریک در حداکثر مقدار است. با افزایش فرکانس سازوکارهای مختلف قادر نخواهند بود از میدان تبعیت کنند و ثابت دی‌الکتریک افت می‌کند [۲۰]. سازوکارهای پلاریزاسیون در محدوده فرکانس‌های مختلف در ماده ایجاد می‌شوند. به همین دلیل کاهش ثابت دی‌الکتریک با افزایش فرکانس در محدوده وسیعی از فرکانس رخ می‌دهد. پلاریزاسیون الکترونی تا فرکانس 10<sup>15</sup> Hz و پلاریزاسیون یونی تقریباً تا فرکانس 10<sup>13</sup> Hz رخ می‌دهد بنابراین در محدوده فرکانس ۸-۱۲ GHz (باند x) پلاریزاسیون الکترونی و یونی سازوکارهای مؤثر بر ثابت دی‌الکتریک هستند [۲۱]. در این محدوده فرکانس تغییر ناگهانی سازوکار پلاریزاسیون رخ نمی‌دهد، در نتیجه تغییر محسوسی در ثابت دی‌الکتریک بوجود

## ۵- مراجع

- [14] H. Zhu et al, "Low Temperature Sintering and Properties of CaO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> System Glass Ceramics for Composite", Vol. 482, pp. 272-275, 2009.
- [15] G. H. Chen and X. Y. Liu, Sintering, "Crystallization and Properties of MgO-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> System Glass-Ceramics Containing ZnO", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 431, pp. 282-286, 2007.
- [16] H. P. Wang, "Synthesis and Microwave Dielectric Properties of CaO-MgO-SiO<sub>2</sub> Submicron Powders Doped with Li<sub>2</sub>O-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> by sol-gel Method", Materials Research Bulletin, Vol. 44, pp. 619-622, 2009.
- [17] M.O.Prdo et al, "On The Sinterability Of Crystallizing Glass Powders", Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 354, pp. 4589-4597, 2008.
- [18] A. Karamanov and M. Peliono, "Sinter-Crystallization in the Diopside- Albite System part I. Formation of Induced Crystallization Porosity", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 26, pp. 2511-2517, 2006.
- [19] A.L.Paula, M.C.Rezende and J.J.Barroso, "Experimental Measurements And Numerical Simulation Of Permittivity And Permeability Of Teflon In X Band", J. Aerosp.Technol. Manag., São José dos Campos, Vol.3, No.1, pp. 59-64, 2011.
- [20] Y. Shimada, Y. Yamashita & H. Takamizawa, "Low Dielectric Constant Multilayer Glass- Ceramic Substrate with Ag-Pd Wiring for VLSI Package", IEEE Transactions On Components, Hybrids, and Manufacturing Technology, Vol. 11, NO. 1, pp. 163-170, 1988.
- [21] M. W. Barsoum, "Fundamentals of Ceramics", pp. 465-484, IOP Publishing Ltd, UK, 2003.
- [22] M. S. Jogad, "Dielectric Measurement on Magnesium Aluminum Silicate Glass-Ceramics Prepared by Different Routes", Materials Letters, Vol. 57, pp. 619-627, 2002.
- [23] F.M. Bertan et al, "Extruded ZrSiO<sub>4</sub> Particulate-Reinforced LZSA Glass-Ceramics Matrix Composite", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 29, pp. 1134-1142, 2009.
- [1] W.Holand and G. Beal, "Glass Ceramic Technology", pp. 15-25, The American Ceramic Society, Westerville, Ohio 43081, 2000.
- [2] E. Le Bourhis, "Glass / Mechanics and Technology", pp. 76-78, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007.
- [3] Dong Kyun Yim, "Microwave Dielectric Properties and Low-Temperature Sintering of Ba<sub>3</sub>Ti<sub>4</sub>Nb<sub>4</sub>O<sub>21</sub> Ceramics with B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and CuO Additions", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 27, pp. 3053-3057, 2007.
- [4] M. T. Sebastian, "Dielectric Materials for Wireless Communication", pp. 1 and 11-13, Elsevier, Oxford, UK, 2008.
- [5] R. Wang et al, "CaF<sub>2</sub>-AlF<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> Glass-Ceramic with Low Dielectric Constant for LTCC Application", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 490, pp. 204-207, 2010.
- [6] S. George and M. T. Sebastian, "Novel Low Loss, Low Permittivity Glass-Ceramic Composites for LTCC Applications", International Journal of Applied Ceramic Technology, Vol. 8, No. 1, pp. 172-179, 2011.
- [7] Z. Yue et al, "Low-Temperature Sinterable Cordierite Glass-Ceramics for High-Frequency Multilayer Chip Inductors", Journal of Materials Science Letters, Vol. 19, pp. 213-215, 2000.
- [8] S. George and M. Th. Sebastian, "Effect of Lithium-Based Glass Addition on the Microwave Dielectric Properties of Ca[(Li<sub>1/3</sub>Nb<sub>2/3</sub>)<sub>1-x</sub>Ti<sub>x</sub>]O<sub>3-δ</sub> Ceramics for LTCC Applications", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 473, pp. 336-340, 2009.
- [9] M. Ohashi et al, "Microwave Dielectric Properties of Low-Temperature Sintered Li<sub>3</sub>AlB<sub>2</sub>O<sub>6</sub> Ceramic", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 25, pp. 2877-2881, 2005.
- [10] J. Kim et al, "Thermal and Dielectric Properties of Glass-Ceramics Sintered Based on Diopside and Anorthite Composition", J Electroceram, Vol. 23, pp. 209-213, 2009.
- [11] K. M. Nair et al, "Dielectric Materials and Device", pp. 492-494, The American Ceramic Society, Westerville, Ohio 43081, 2002.
- [12] M. W. Chang et al, "Properties of Glasses Based on the CaO-MgO-SiO<sub>2</sub> System for Low-Temperature Co-Fired Ceramic", Ceramics International, Vol. 35, pp. 2513-2515.
- [13] C. Chiang, "Densification and Microwave Dielectric Properties of CaO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> System Glass-Ceramics", Ceramics International, Vol. 34, pp. 599-604, 2008.

## ۶- پی نوشت

- 1- Substrate
- 2- Microwave Integrated Circuits (MIC)
- 3- Low Temperature Co-fired Ceramic
- 4- Passive
- 5- Inductors
- 6- Cordierite
- 7- Waveguide